

紫外宽谱光刻胶 BN301系列紫外负型光刻胶

产品名称	紫外宽谱光刻胶 BN301系列紫外负型光刻胶
公司名称	厦门良厦贸易有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	中国（福建）自由贸易试验区厦门片区中埔社10190号（注册地址）
联系电话	0592-6013840 15396145919

产品详情

BN303系列紫外负型光刻胶是一类采用宽谱紫外线曝光的负性光刻胶，主要用于中小规模集成电路、分立器件及其它微型器件的制作。本产品粘度可以在 29 - 100 mPa.s范围内调整，覆盖光刻胶膜厚范围0.85-2.1um. 实用分辨率可达5 μ m, 在多种基片上均有良好的粘附性,抗湿法腐蚀性能良好。

BN301系列紫外负型光刻胶是一类采用宽谱紫外线曝光的负性光刻胶，主要用于半导体分立器件及其它微型器件的制作。本产品粘度可以在20-60mPa.s范围内调整，覆盖光刻胶膜厚范围2.0-3.0um, 在多种基片上均有良好的粘附性,抗湿法腐蚀性能良好。

BN308系列紫外负型光刻胶是一类采用宽谱紫外线曝光的负性光刻胶，主要用于分立器件及其它微型器件的制作。本产品粘度可以在140 - 500mPa.s范围内调整，覆盖光刻胶膜厚范围2.2-6um. 实用分辨率可达8 μ m, 在多种基片上均有良好的粘附性,抗湿法腐蚀性能优异。

C7600	R:0.30 μ m,Thickness range:7000A-12000A	0.3um process
C7500	R:0.4 μ m,Thickness range:7000A-12000A	0.4 μ m process
C7510	R:0.5 μ m,Thickness range:19000A-36000A	0.5um process
C7310	R:0.45 μ m,Thickness:13000A-15000A	0.5 μ m process
C8315	R:0.65 μ m,High heat resistance	0.65 μ m process
C8325	R:0.9 μ m,Thickness:14000A-23000A	0.9 μ m process
C8350	R:1.2 μ m,Thickness:20000A-35000A	Metal/Passivation
C5315	R:0.65 μ m,Thickness:10000A-17000A	0.65 μ m process
EP3200A	R:1.0 μ m,Thickness:20000-35000A	LED positive resist